

仙台高等専門学校	開講年度	平成27年度(2015年度)	授業科目	材料物性Ⅱ		
科目基礎情報						
科目番号	0023	科目区分	専門 / 必修			
授業形態	授業	単位の種別と単位数	学修単位: 2			
開設学科	マテリアル環境工学科	対象学年	4			
開設期	前期	週時間数	2			
教科書/教材						
担当教員	浅田 格					
到達目標						
材料のもつ物理的性質を左右する物質中の電子の振る舞いについてイメージでき、材料開発の基礎的素養を身につける。電子物性Iに継続する内容を理解した上で、さまざまな物性を実際の現象と理論やそれに基づく式などを用いて、自らの理解の上で説明していくことができる。						
ループリック						
	理想的な到達レベルの目安	標準的な到達レベルの目安	未到達レベルの目安			
評価項目1						
評価項目2						
評価項目3						
学科の到達目標項目との関係						
教育方法等						
概要	新たな材料の開発には、材料の持つ物理的、化学的性質の理解が一層重要となっている。特に物性の理解は、材料に機能性を持たせる際に重要な電気的、熱的、光学的、磁気的な諸性質を左右する基本的な現象を捉える上で必要である。これら性質と現象の本質的な理解を目的とする。					
授業の進め方・方法	授業では教科書と配布図面を利用しながら説明を進める。その復習として、物性の理解を確認するために、説明問題、物性値を求める問題などの演習課題を配付するので、次回授業の時に提出すること。					
注意点	物理、応用物理および電子物性Iでの学習内容を十分理解しておくこと。					
授業計画						
	週	授業内容	週ごとの到達目標			
前期	1stQ	1週	1.量子数と状態	量子数とエネルギー状態の演習を通して理解を深める。		
		2週	2.格子振動	格子振動の復習。原子振動、1次元格子振動モデルを理解し導出できる。格子振動が関わる物性とフォノンを説明できる。		
		3週	3.固体の比熱 ～固体の比熱、AINシュタインモデル～	比熱、定積モル比熱の考え方を理解できる。AINシュタインモデルの比熱モデルを理解する。		
		4週	3.固体の比熱 ～デバイモデル～	デバイの比熱モデルを理解する。		
		5週	3.固体の比熱 ～固体の熱伝導・熱膨張～	比熱と関連する物性の説明ができる。		
		6週	4.結晶中のエネルギー状態 ～エネルギーバンドの形成～	エネルギーバンドの形成を理解する。		
		7週	4.結晶中のエネルギー状態 ～自由電子模型と電気伝導～	電気伝導の古典的モデルの理解をする。		
		8週	4.結晶中のエネルギー状態 ～金属の自由電子モデル～	固体中の自由電子の挙動を説明できる。		
	2ndQ	9週	4.結晶中のエネルギー状態 ～期ボテンシャル場中の電子～	周期ポテンシャル場中にある電子の運動を説明できる。		
		10週	4.結晶中のエネルギー状態 ～期ボテンシャル場中の電子～	周期ポテンシャルと電気伝導性を理解する。		
		11週	5.半導体材料と物性 ～半導体の種類～	半導体の種類について説明できる。		
		12週	5.半導体材料と物性 ～真性半導体の性質～	不純物半導体の特徴を真性半導体と区別して説明できる。		
		13週	5.半導体材料と物性 ～不純物半導体の性質～	不純物半導体の添加元素の特徴、エネルギーバンドと不純物準位および伝導機構について説明できる。		
		14週	6.磁性材料と物性 ～磁性の起源～	磁性の基礎、磁気モーメントの導出ができる。		
		15週	6.磁性材料と物性 ～物質の磁性～	磁性の分類と基本的な物質の持つ磁性を説明できる。		
		16週				
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標						
分類	分野	学習内容	学習内容の到達目標	到達レベル	授業週	
専門的能力	分野別の専門工学	材料系分野	材料物性	陽子・中性子・電子からなる原子の構造について説明できる。	4	前1
				ボーアの水素原子模型を用いて、エネルギー準位を説明できる。	4	前1
				水素原子中の電子のエネルギー状態が離散的な値を取ることを説明できる。	4	前1
				量子条件から電子のエネルギー状態および軌道半径を導出し、説明できる。	4	前1
				4つの量子数を用いて量子状態を記述して、電子殻や占有する電子数などを説明できる。	4	前1
				周期表の元素配列に対して、電子配置や各族および周期毎の物性の特徴を関連付けられる。	4	前1

			電子が持つ粒子性と波動性について、現象を例に挙げ、式を用いて説明できる。	4	前1,前2
			量子力学的観点から電気伝導などの現象を説明できる。	4	前2,前6,前7,前8,前9,前10
			半導体の種類について説明できる。	3	前11
			不純物半導体の特徴を真性半導体と区別して説明できる。	3	前12
			不純物半導体のエネルギーバンドと不純物準位を描き、伝導機構について説明できる。	3	前13

評価割合

	試験	発表	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	合計
総合評価割合	80	0	0	0	0	20	100
基礎的能力	0	0	0	0	0	0	0
専門的能力	80	0	0	0	0	20	100
分野横断的能力	0	0	0	0	0	0	0